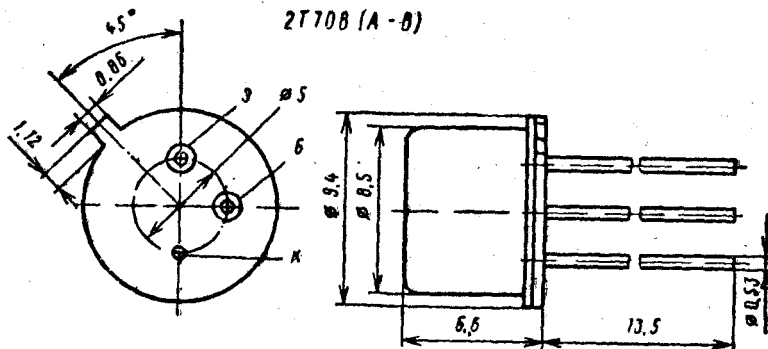


2Т708 (А, Б, В)

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *p-n-p* составные переключаемые. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КВ}=5$ В, $I_{Э}=2$ А, не менее:

$T = +25^{\circ}\text{C}$:

2Т708А	500
2Т708Б, 2Т708В	750

$T = -60^{\circ}\text{C}$:

2Т708А	150
2Т708Б, 2Т708В	200

$T = +125^{\circ}\text{C}$:

2Т708А	400
2Т708Б, 2Т708В	600

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КВ}=10$ В, $I_{Э}=5$ А, не менее:

2Т708А	150*
типовое значение	400*
2Т708Б, 2Т708В	250*
типовое значение	600*

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КВ}=5$ В, $I_{Э}=0,1$ А, не менее

3* МГц

Граничное напряжение при $I_{Э}=50$ мА, $t_{ц} \leq 30$ мкс, $Q \geq 100$:

2Т708А	80...90*...100* В
2Т708Б	60...70*...80* В
2Т708В	40...50*...60* В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{К}=2$ А, $I_{Б}=0,01$ А

1,1*...1,4*...2 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_{К}=2$ А, $I_{Б}=0,01$ А

1,7*...2*...2,5 В

Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{бэ} \leq 1$ кОм, $I_{КВР}=1$ мА:

2Т708А	100...130*...150* В
2Т708Б	80...88*...100* В
2Т708В	60...72*...80* В

Пробивное напряжение коллектор — база:

при $I_{КВЭ}=1$ мА, $T = +25^{\circ}\text{C}$:

2Т708А	100...130*...150* В
2Т708Б	80...88*...100* В
2Т708В	60...75*...80* В

при $I_{КВЭ}=1$ мА, $T = -60^{\circ}\text{C}$ и $I_{КВЭ}=5$ мА, $T = +125^{\circ}\text{C}$, не менее:

2Т708А	100 В
2Т708Б	80 В
2Т708В	60 В

Пробивное напряжение эмиттер — база при $I_{ВЭВ}=5$ мА

5...6*...10* В

Время включения при $I_K=2$ А, $I_B=0,01$ А, $t_n=$	$0,5^* \dots 0,8^* \dots 1^*$ мкс
$=25$ мкс	
Время выключения при $I_K=2$ А, $I_B=0,01$ А, $t_n=$	$1,8^* \dots 2,3^* \dots 4^*$ мкс
$=25$ мкс	

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер¹ при

$R_{02} \leq 1$ кОм, $T = -60^\circ\text{C} \dots T_n = +55^\circ\text{C}$:

2Т708А	100 В
2Т708Б	80 В
2Т708В	60 В

Постоянное напряжение коллектор — база:

2Т708А	100 В
2Т708Б	80 В
2Т708В	60 В

Постоянное напряжение эмиттер — база

Постоянный ток коллектора²

Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 2$ мс, $Q > 2^{2,3}$

Постоянный ток базы²

Импульсный ток базы при $t_n \leq 2$ мс, $Q > 2^{2,3}$

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

с теплоотводом, $T = -60^\circ\text{C} \dots T_n = +25^\circ\text{C}$ ⁴

без теплоотвода, $T = -60^\circ\text{C} \dots T_n = +25^\circ\text{C}$ ⁴

Температура $p-n$ перехода

Температура окружающей среды

$-60^\circ\text{C} \dots T_n = +125^\circ\text{C}$

¹ При $T_n > +55^\circ\text{C}$ напряжение снижается линейно.

² Без превышения значения постоянной рассеиваемой мощности коллектора.

³ При $Q \leq 2$ токи рассчитываются по формулам

$$I_{K, \text{ макс. А}} = I_{K, \text{ макс. Q}}$$

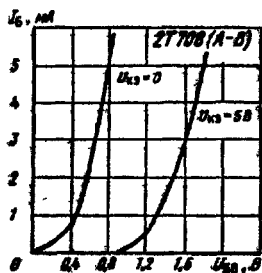
$$I_{B, \text{ макс. А}} = I_{B, \text{ макс. Q}}$$

⁴ При $T_n = +25 \dots +125^\circ\text{C}$ при использовании транзистора с теплоотводом и при $T = +25 \dots +125^\circ\text{C}$ при использовании транзистора без теплоотвода рассеиваемая мощность коллектора снижается линейно.

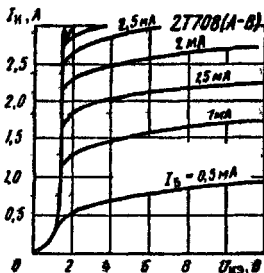
Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода транзистора не менее 3 мм.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 3 мм от корпуса. Температура пайки не более $+260^\circ\text{C}$, время пайки 3 с.

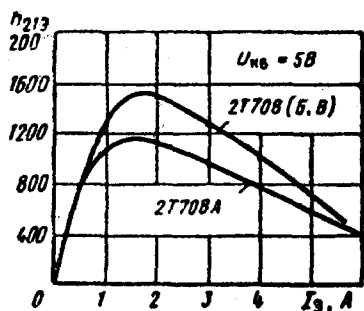
При включении питающих напряжений, а также при переходных процессах не допускается превышение области максимальных режимов. При работе с пиковой мощностью при длительности, промежуточной для значений, приведенных на области максимальных режимов, не рекомендуется превышать границы, области максимальных режимов для ближайшего большего значения длительности.



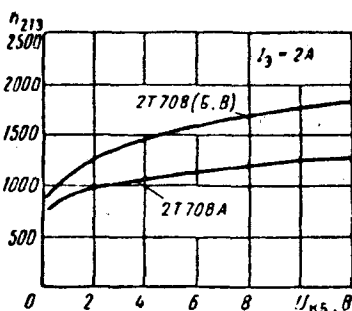
Зависимости тока базы от напряжения база — эмиттер



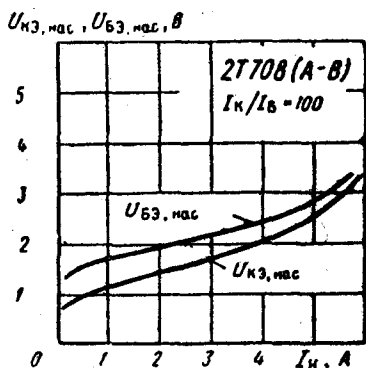
Зависимости тока коллектора от напряжения коллектор — эмиттер



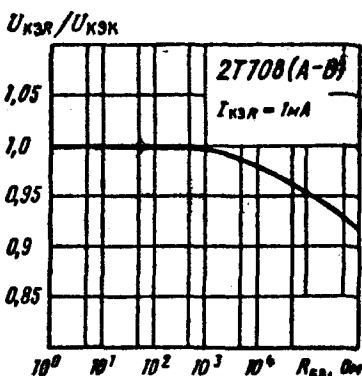
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



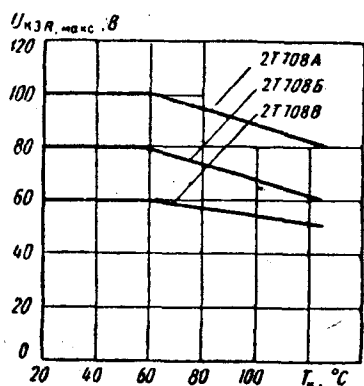
Зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор — база



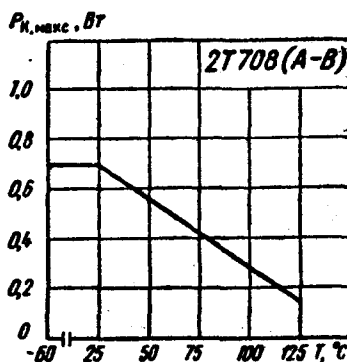
Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



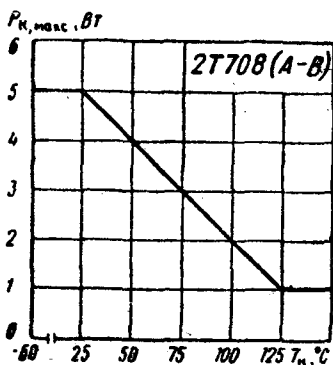
Зависимость допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления в цепи база — эмиттер



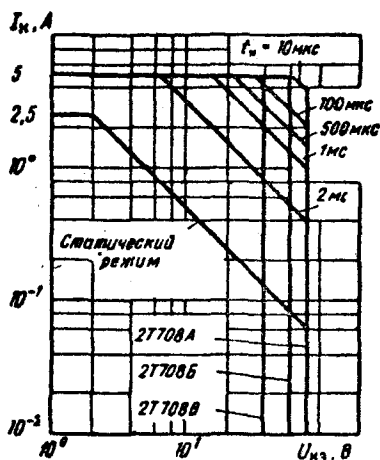
Зависимости допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от температуры корпуса



Зависимость допустимой рассеиваемой мощности коллектора от температуры



Зависимость допустимой рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса



Области максимальных режимов